

武汉理工大学

武汉理工大学 2005 年研究生入学考试试题

课程代码 _____ 课程名称 材料科学基础

(共 3 页, 共七题, 答题时不必抄题, 标明题目序号, 相图直接做在试卷上, 不必重新画图)

一、解释下列基本概念, 并简述其与材料(或晶体)性质或性能的关系(36分)

1. 空间利用率;
2. 位错滑移;
3. 孪反常;
4. 弛豫界面;
5. 独立析晶;
6. 晶界扩散;
7. 非均态核化;
8. 弥散强化;
9. 矿化剂;
10. 二次再结晶;
11. 应力腐蚀;
12. 穿晶断裂。

二、钙钛矿 ABO_3 型结构属于立方晶系, 其中 2 价正离子位于立方晶胞顶点位置, 4 价正离子位于立方晶胞体心位置, 2 价负离子位于立方晶胞面心位置。(20 分)

1. 画出钙钛矿型结构的晶胞投影图;
2. 指出晶胞中各离子的配位数;
3. 根据鲍林规则计算 O^{2-} 离子电价是否平衡;
4. $BaTiO_3$ 和 $CaTiO_3$ 都属于钙钛矿结构, 其中 $BaTiO_3$ 晶体具有铁电效应而 $CaTiO_3$ 没有, 请从结构方面予以解释;
5. 证明形成理想钙钛矿结构时, 两种阳离子半径 r_A 、 r_B 与氧离子半径 r_O 之间满足下面的关系式 $r_A + r_O = \sqrt{2}(r_B + r_O)$; 分

三、计算题(15分)

1. MgO 晶体中, Schottky 缺陷的生成能为 $6eV$, 计算在 $25^\circ C$ 和 $1600^\circ C$ 时热缺陷的浓度。
($1eV=1.6 \times 10^{-19} J$)
2. 如果 MgO 晶体中, 含有 $10^{-6} mol$ 的 Al_2O_3 杂质, 则在 $1600^\circ C$ 时, MgO 晶体中是热缺陷占优势还是杂质缺陷占优势, 说明原因。
3. 此时 MgO 晶体中的扩散是本征扩散还是非本征扩散占主导地位?
4. 如果 Al_2O_3 杂质的含量为 $10^{-8} mol$, 其 $\ln D \sim 1/T$ 曲线转折点向何方向移动, 为什么?

四、请阐述书写组成缺陷反应方程式时应遵循的基本原则，依据上述原则写出下列缺陷反应方程式，根据书写过程总结出书写组成缺陷反应方程式的一般规律。(20分)

1. ZrO_2 加入到 Al_2O_3 中；
2. CaF_2 加入到 YF_3 中。

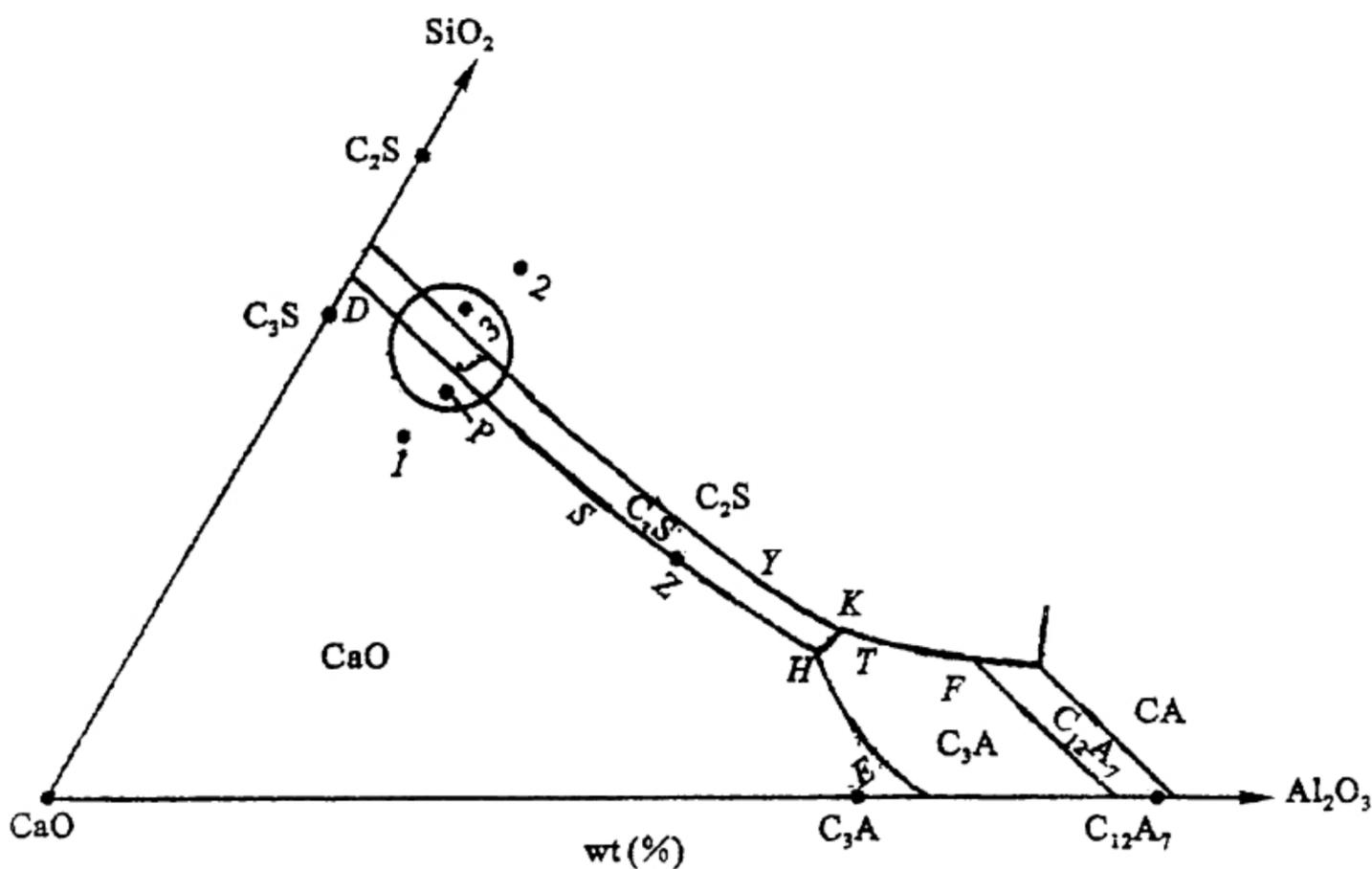
五、在成核-生长相变中，当形成为半径 r 的球形新相时，整个系统自由焓的变化 ΔG_r 应为体积的自由焓变化、界面能变化和应变能的代数和，即

$$\Delta G_r = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma_{LS} + \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_E$$

式中： r 为球形新相的半径， γ_{LS} 为液-固界面能， ΔG_V 、 ΔG_E 分别为除去界面能外单位体积的自由焓和应变能的变化。(12分)

1. 确定新相可以稳定成长的临界半径及相变势垒；
2. 在什么情况下处理问题时可以忽略应变能的影响？
3. 说明新相形成初期温度起伏与新相形成的关系。

六、下图是 $CaO-Al_2O_3-SiO_2$ 系统中的富钙部分 $CaO-C_2S-C_{12}A_7$ 系统，根据相图解答以下问题。(27分)



第六题图

1. 请将该区域副三角形化；
2. 用箭头表示界线温度变化方向及界线性质；
3. 判断化合物 C_2S 、 C_3S 、 C_3A 、 $C_{12}A_7$ 的性质；

4. 写出 H、K、F 点的平衡过程，并指出无变量点的性质；
5. 写出 P 点的平衡结晶过程；
6. 比较 1、2、3 点平衡条件下的结晶产物；
7. P 点的组成实际冷却过程中会发生独立析晶现象吗？

七、选择题，在下面 6 道题中任意选择 2 道题。（10×2 分）

1. 烧结中后期的正常晶粒长大与二次再结晶有什么区别？
2. 简述影响扩散的因素。
3. 简述影响固相反应速率的因素。
4. 论述广义腐蚀对材料性能的影响。
5. 分析表面粗糙度对表面力场及润湿的影响。
6. 叙述非晶态金属和晶态金属在结构和性质上的差异。